



三洋半導体
ニュース

No 1467

0193

STK4026

厚膜混成集積回路
25W min AF パワーアンプ

- 特長
- ・薄型セット対応のため パッケージが小型化されている。
 - ・出力 6W~50Wまでシリーズ化を図り ピンは共通となっている。
 - ・薄型ステレオセットのICの発熱を分散し 放熱設計を容易にする。
 - ・電源スイッチ オン、オフ時のショック音のミュートング および 負荷ショート保護回路、サーマルシャットダウン等の電子的付加回路が設計できるようになっている。

最大定格/ $T_a=25^{\circ}\text{C}$

			unit
最大電源電圧	$V_{CC\ max}$	± 38	V
熱抵抗	θ_{j-c}	2.4	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
接合部温度	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
動作時 IC 基板温度	T_c	125	$^{\circ}\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	$-30\sim+125$	$^{\circ}\text{C}$
負荷短絡許容時間	t_{s*}	$V_{CC}=\pm 26\text{V}, R_L=8\Omega,$ $f=50\text{Hz}, P_o=25\text{W}$	2 sec

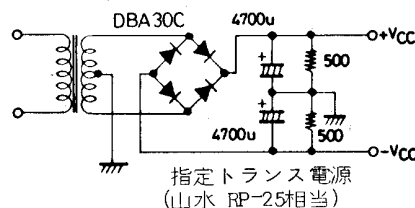
動作特性/ $T_a=25^{\circ}\text{C}, V_{CC}=\pm 26\text{V}, R_L=8\Omega, V_G=40\text{dB}, R_g=600\Omega, R_L$ は無誘導負荷とする。

			min	typ	max	unit
無信号電流	I_{cco}	$V_{CC}=\pm 30\text{V}$	10	20	50	mA
出力電力	$P_o(1)$	$\text{THD}=0.5\%, f=20\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$	25			W
	$P_o(2)$	$V_{CC}=\pm 22\text{V}, \text{THD}=1.0\%,$ $R_L=4\Omega, f=1\text{kHz}$	25			W
全高調波歪み率	THD	$P_o=1.0\text{W}, f=1\text{kHz}$			0.3	%
周波数特性	f_L, f_H	$P_o=1.0\text{W}, +0-3\text{dB}$		20~50k		Hz
入力インピーダンス	r_i	$P_o=1.0\text{W}, f=1\text{kHz}$		32		k Ω
出力雑音電圧	V_{N0}^{**}	$V_{CC}=\pm 30\text{V}, R_g=10\text{k}\Omega$			1.2	mV rms
中点電圧	V_N	$V_{CC}=\pm 30\text{V}$	-70	0	70	mV

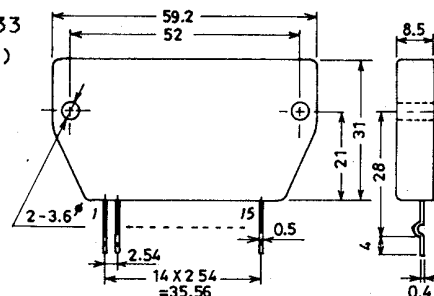
- ・検査時の電源には指定のないかぎり 定電圧電源を使用する。

※：負荷短絡許容時間 および 出力雑音電圧の測定は 右図の指定トランス電源を使用する。

※※：出力雑音電圧は 平均値指示型実効値目盛電圧計のピーク値を示し 雑音電圧波形にはパルス性ノイズは含まない。



外形図 4033
(unit:mm)



* これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。